



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2019-0135862
(43) 공개일자 2019년12월09일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01L 21/67 (2006.01) H01L 21/677 (2006.01)
H01L 25/075 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H01L 21/67144 (2013.01)
H01L 21/67712 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0061372
(22) 출원일자 2018년05월29일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
(주)포인트엔지니어링
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 89
(72) 발명자
안범모
경기도 수원시 영통구 에듀타운로 35, 5104-1502
박승호
경기도 화성시 향남읍 행정중앙1로 39, 403-1001
변성현
경기도 화성시 동탄반석로 264, 106-803
(74) 대리인
최광석

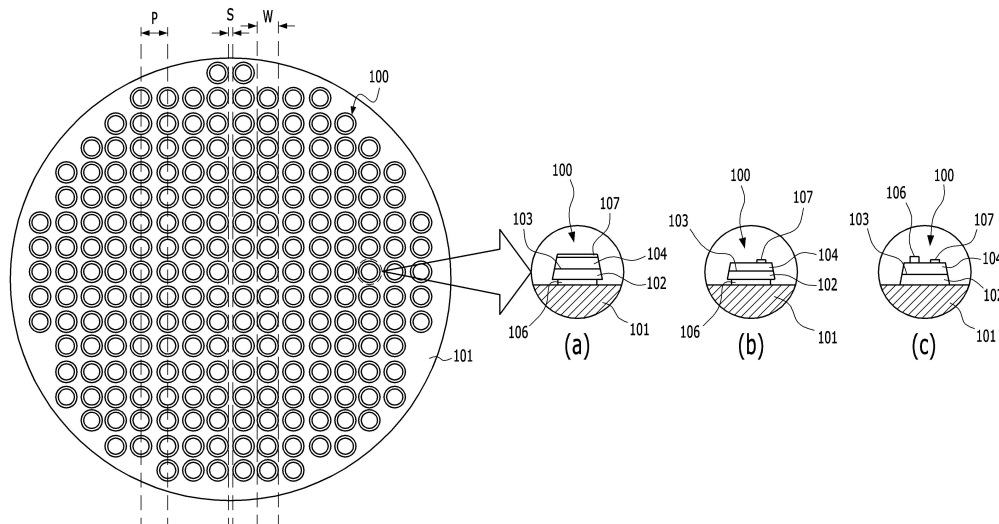
전체 청구항 수 : 총 19 항

(54) 발명의 명칭 마이크로 LED 전사 시스템

(57) 요약

본 발명은 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척할 때 마이크로 LED 전사헤드의 세척을 수행하는 공간에 외부 이물질이 유입되는 것을 방지하여 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면의 세척 효율을 높일 수 있는 마이크로 LED 전사시스템에 관한 것이다.

대표도



(52) CPC특허분류

H01L 21/67721 (2013.01)

H01L 25/0753 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

흡착면으로 마이크로 LED를 흡착하고 상기 흡착면보다 하부로 돌출되도록 테두리에 형성되는 실링부를 포함하는 마이크로 LED 전사헤드; 및

상기 흡착면을 세척하는 클리닝 장치;를 포함하고

상기 흡착면을 세척할 때 상기 실링부는 상기 클리닝 장치의 상면에 접촉하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 실링부는 탄성재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 마이크로 LED 전사헤드의 하단부가 상기 클리닝 장치의 상면과 이격되게 위치하면서 클리닝 공간이 형성되는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 실링부는 상기 클리닝 장치가 상기 마이크로 LED 전사헤드를 세척할 때 상기 클리닝 공간에 유입되는 외부 이물질들을 차단하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 흡착하기 전의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면 또는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 이송하여 실장시킨 후의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 플라즈마를 발생하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 퍼지 가스를 분사하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 이온풍을 분사하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 정전기를 제거하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 10

흡착면으로 마이크로 LED를 흡착하는 마이크로 LED 전사헤드;

상기 흡착면을 세척하는 클리닝 장치; 및

상기 클리닝 장치의 테두리에 상기 클리닝 장치의 상부로 돌출되도록 형성되는 실링부를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 실링부는 탄성재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 12

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치가 상기 흡착면을 세척할 때 상기 실링부는 상기 마이크로 LED 전사헤드의 테두리 하면에 접촉하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 13

제10항에 있어서,

상기 마이크로 LED 전사헤드의 하단부가 상기 클리닝 장치의 상면과 이격되게 위치하면서 클리닝 공간이 형성되는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 14

제10항에 있어서,

상기 실링부는 상기 클리닝 장치가 상기 마이크로 LED 전사헤드를 세척할 때 상기 클리닝 공간에 유입되는 외부 이물질을 차단하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 15

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 흡착하기 전의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면 또는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 이송하여 실장시킨 후의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척하는 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 16

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 플라즈마를 발생하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 17

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 퍼지 가스를 분사하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 18

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 이온풍을 분사하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

청구항 19

제10항에 있어서,

상기 클리닝 장치는 정전기를 제거하는 장치인 것을 특징으로 하는 마이크로 LED 전사 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 마이크로 LED 전사 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 현재 디스플레이 시장은 아직은 LCD가 주류를 이루고 있는 가운데 OLED가 LCD를 빠르게 대체하며 주류로 부상하고 있는 상황이다. 디스플레이 업체들의 OLED 시장 참여가 러시를 이루고 있는 상황에서 최근 Micro LED(이하, '마이크로 LED'라 함) 디스플레이가 또 하나의 차세대 디스플레이로 부상하고 있다. LCD와 OLED의 핵심소재가 각각 액정(Liquid Crystal), 유기재료인데 반해 마이크로 LED 디스플레이는 1~100마이크로미터(μm) 단위의 LED 칩 자체를 발광재료로 사용하는 디스플레이이다.

[0003] Cree사가 1999년에 "광 적출을 향상시킨 마이크로-발광 다이오드 어레이"에 관한 특허를 출원하면서(등록특허공보 등록번호 제0731673호), 마이크로 LED 라는 용어가 등장한 이래 관련 연구 논문들이 잇달아 발표되면서 연구 개발이 이루어지고 있다. 마이크로 LED를 디스플레이에 응용하기 위해 해결해야 할 과제로 마이크로 LED 소자를 Flexible 소재/소자를 기반으로 하는 맞춤형 마이크로 칩 개발이 필요하고, 마이크로 미터 사이즈의 LED 칩의 전사(transfer)와 디스플레이 픽셀 전극에 정확한 실장(Mounting)을 위한 기술이 필요하다.

[0004] 특히, 마이크로 LED 소자를 표시 기판에 이송하는 전사(transfer)와 관련하여, LED 크기가 1~100 마이크로미터

(μm) 단위까지 작아짐에 따라 기존의 픽애플레이스(pick & place) 장비를 사용할 수 없고, 보다 고정밀도로 이송하는 전사 헤드기술이 필요하게 되었다. 이러한 전사 헤드 기술과 관련하여, 이하에서 살펴보는 바와 같은 몇 가지의 구조들이 제안되고 있으나 각 제안 기술은 몇 가지의 단점들을 가지고 있다.

[0005] 미국의 Luxvue사는 정전헤드(electrostatic head)를 이용하여 마이크로 LED를 전사하는 방법을 제안하였다(공개특허공보 공개번호 제2014-0112486호, 이하 '선행발명1'이라 함). 미국의 X-Celeprint사는 전사 헤드를 탄성이 있는 고분자 물질로 적용하여 웨이퍼 상의 마이크로 LED를 원하는 기판에 이송시키는 방법을 제안하였다(공개특허공보 공개번호 제2017-0019415호, 이하 '선행발명2'라 함). 한국광기술원은 섬모 집착구조 헤드를 이용하여 마이크로 LED를 전사하는 방법을 제안하였다(등록특허공보 등록번호 제1754528호, 이하 '선행발명3'이라 함). 한국기계연구원은 롤러에 집착제를 코팅하여 마이크로 LED를 전사하는 방법을 제안하였다(등록특허공보 등록번호 제1757404호, 이하 '선행발명4'라 함). 삼성디스플레이는 어레이 기판이 용액에 담겨 있는 상태에서 어레이 기판의 제1,2전극에 마이너스 전압을 인가하여 정전기 유도 현상에 의해 마이크로 LED를 어레이 기판에 전사하는 방법을 제안하였다(공개특허공보 제10-2017-0026959호, 이하 '선행발명5'라 함). 엘지전자는 헤드홀더를 복수의 픽업헤드들과 기판 사이에 배치하고 복수의 픽업 헤드의 움직임에 의해 그 형상이 변형되어 복수의 픽업 헤드들에게 자유도를 제공하는 방법을 제안하였다(공개특허공보 제10-2017-0024906호, 이하 '선행발명6'이라 함).

[0006] 위와 같은 선행발명 1 내지 6은, 마이크로 LED를 어떻게 전사할 것인지에만 초점을 두고 있다. 그러나 마이크로 LED를 제1기판에서 제2기판으로 전사함에 있어서 전사헤드가 마이크로 LED를 흡착 및 탈착할 때 흡착 및 탈착을 방해하는 방해요인들을 어떻게 제거할 것인지에 대해서는 제안하지 못하고 있는 실정이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0007] (특허문헌 0001) 등록특허공보 등록번호 제0731673호
(특허문헌 0002) (특허문헌 2) 공개특허공보 공개번호 제2014-0112486호
(특허문헌 0003) 공개특허공보 공개번호 제2017-0019415호
(특허문헌 0004) 등록특허공보 등록번호 제1754528호
(특허문헌 0005) 등록특허공보 등록번호 제1757404호
(특허문헌 0006) 공개특허공보 제10-2017-0026959호
(특허문헌 0007) 공개특허공보 제10-2017-0024906호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 이에 본 발명은 흡착면으로 마이크로 LED를 흡착하는 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척하는 과정에서 흡착면을 세척하는 클리닝 공간으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단하여 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 보다 효율적으로 세척할 수 있는 마이크로 LED 전사 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 일 특징에 따른 마이크로 LED 전사 시스템은, 흡착면으로 마이크로 LED를 흡착하고 상기 흡착면보다 하부로 돌출되도록 테두리에 형성되는 실링부를 포함하는 마이크로 LED 전사헤드; 및 상기 흡착면을 세척하는 클리닝 장치;를 포함하고 상기 흡착면을 세척할 때 상기 실링부는 상기 클리닝 장치의 상면에 접촉하는 것을 특징으로 한다.

[0010] 또한, 상기 실링부는 탄성재질로 구성되는 것을 특징으로 한다.

[0011] 또한, 상기 마이크로 LED 전사헤드의 하단부가 상기 클리닝 장치의 상면과 이격되게 위치하면서 클리닝 공간이 형성되는 것을 특징으로 한다.

- [0012] 또한, 상기 실링부는 상기 클리닝 장치가 상기 마이크로 LED 전사헤드를 세척할 때 상기 클리닝 공간에 유입되는 외부 이물질을 차단하는 것을 특징으로 한다.
- [0013] 또한, 상기 클리닝 장치는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 흡착하기 전의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면 또는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 이송하여 실장시킨 후의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척하는 것을 특징으로 한다.
- [0014] 또한, 상기 클리닝 장치는 플라즈마를 발생하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0015] 또한, 상기 클리닝 장치는 퍼지 가스를 분사하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0016] 또한, 상기 클리닝 장치는 이온풍을 분사하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0017] 또한, 상기 클리닝 장치는 정전기를 제거하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0018] 본 발명의 다른 특징에 따른 마이크로 LED 전사 시스템은 흡착면으로 마이크로 LED를 흡착하는 마이크로 LED 전사헤드; 상기 흡착면을 세척하는 클리닝 장치; 및 상기 클리닝 장치의 테두리에 상기 클리닝 장치의 상부로 돌출되도록 형성되는 실링부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0019] 또한, 상기 실링부는 탄성재질로 구성되는 것을 특징으로 한다.
- [0020] 또한, 상기 클리닝 장치가 상기 흡착면을 세척할 때 상기 실링부는 상기 마이크로 LED 전사헤드의 테두리 하면에 접촉하는 것을 특징으로 한다.
- [0021] 또한, 상기 마이크로 LED 전사헤드의 하단부가 상기 클리닝 장치의 상면과 이격되게 위치하면서 클리닝 공간이 형성되는 것을 특징으로 한다.
- [0022] 또한, 상기 실링부는 상기 클리닝 장치가 상기 마이크로 LED 전사헤드를 세척할 때 상기 클리닝 공간에 유입되는 외부 이물질을 차단하는 것을 특징으로 한다.
- [0023] 또한, 상기 클리닝 장치는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 흡착하기 전의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면 또는 상기 마이크로 LED 전사헤드가 상기 마이크로 LED를 이송하여 실장시킨 후의 상기 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척하는 것을 특징으로 한다.
- [0024] 또한, 상기 클리닝 장치는 플라즈마를 발생하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0025] 또한, 상기 클리닝 장치는 퍼지 가스를 분사하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0026] 또한, 상기 클리닝 장치는 이온풍을 분사하는 장치인 것을 특징으로 한다.
- [0027] 또한, 상기 클리닝 장치는 정전기를 제거하는 장치인 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0028] 이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명에 의한 마이크로 LED 전사 시스템은 실링부를 구비하여 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면의 흡착을 저하시키는 이물질과 같은 방해 요인을 세척할 시, 클리닝 공간을 밀폐하여 클리닝 공간으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단할 수 있다. 이로 인해 클리닝 공간에는 클리닝 공간의 이물질과 흡착면의 이물질만이 존재하게 되고 클리닝 장치는 클리닝 공간에 유입된 외부 이물질로 인한 방해 없이 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면을 세척할 수 있으므로 마이크로 LED 전사 시스템의 세척 효율을 향상시킬 수 있는 효과를 얻을 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명의 실시예들의 이송대상인 마이크로 LED를 도시한 도.
- 도 2는 본 발명의 실시예들에 의해 표시기판에 이송되어 실장된 마이크로 LED 구조체의 도.
- 도 3(a)는 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템의 동작 전 상태를 도시한 도.
- 도 3(b)는 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템의 동작 후 상태를 도시한 도.
- 도 4는 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템의 배치를 도시한 도.
- 도 5는 본 발명의 제2실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템을 도시한 도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 이하의 내용은 단지 발명의 원리를 예시한다. 그러므로 당업자는 비록 본 명세서에 명확히 설명되거나 도시되지 않았지만 발명의 원리를 구현하고 발명의 개념과 범위에 포함된 다양한 장치를 발명할 수 있는 것이다. 또한, 본 명세서에 열거된 모든 조건부 용어 및 실시 예들은 원칙적으로, 발명의 개념이 이해되도록 하기 위한 목적으로만 명백히 의도되고, 이와 같이 특별히 열거된 실시 예들 및 상태들에 제한적이지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0031] 상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다.
- [0032] 본 명세서에서 기술하는 실시 예들은 본 발명의 이상적인 예시 도인 단면도 및/또는 사시도들을 참고하여 설명될 것이다. 이러한 도면들에 도시된 막 및 영역들의 두께 및 구멍들의 지름 등은 기술적 내용의 효과적인 설명을 위해 과장된 것이다. 제조 기술 및/또는 허용 오차 등에 의해 예시도의 형태가 변형될 수 있다. 또한 도면에 도시된 마이크로 LED의 개수는 예시적으로 일부만을 도면에 도시한 것이다. 따라서, 본 발명의 실시 예들은 도시된 특정 형태로 제한되는 것이 아니라 제조 공정에 따라 생성되는 형태의 변화도 포함하는 것이다.
- [0033] 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, 동일한 기능을 수행하는 구성요소에 대해서는 실시예가 다르더라도 편의상 동일한 명칭 및 동일한 참조번호를 부여하기로 한다. 또한, 이미 다른 실시예에서 설명된 구성 및 작동에 대해서는 편의상 생략하기로 한다.
- [0034] 이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
- [0035] 도 1은 본 발명의 실시예들의 이송대상이 되는 마이크로 LED를 도시한 도이고, 도 2는 본 발명의 실시예들에 의해 이송되어 실장된 마이크로 LED 구조체의 도이다.
- [0036] 도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 LED 전사헤드의 흡착 대상이 되는 복수의 마이크로 LED(100)를 도시한 도면이다. 마이크로 LED(100)는 성장 기관(101) 위에서 제작되어 위치한다.
- [0037] 성장 기관(101)은 전도성 기관 또는 절연성 기관으로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 성장 기관(101)은 사파이어, SiC, Si, GaAs, GaN, ZnO, Si, GaP, InP, Ge, 및 Ga₂O₃ 중 적어도 어느 하나로 형성될 수 있다.
- [0038] 마이크로 LED(100)는 제1 반도체층(102), 제2 반도체층(104), 제1 반도체층(102)과 제2 반도체층(104) 사이에 형성된 활성층(103), 제1 컨택전극(106) 및 제2 컨택전극(107)을 포함할 수 있다.
- [0039] 제1 반도체층(102), 활성층(103), 및 제2 반도체층(104)은 유기금속 화학 증착법(MOCVD; Metal Organic Chemical Vapor Deposition), 화학 증착법(CVD; Chemical Vapor Deposition), 플라즈마 화학 증착법(PECVD; Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition), 분자선 성장법(MBE; Molecular Beam Epitaxy), 수소화물 기상 성장법(HVPE; Hydride Vapor Phase Epitaxy) 등의 방법을 이용하여 형성할 수 있다.
- [0040] 제1 반도체층(102)은 예를 들어, p형 반도체층으로 구현될 수 있다. p형 반도체층은 In_xAl_yGa_{1-x-y}N (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ x+y ≤ 1)의 조성식을 갖는 반도체 재료, 예를 들어 GaN, AlN, AlGa_{1-x-y}N, InGa_{1-x-y}N, InN, InAlGa_{1-x-y}N, AlInN 등에서 선택될 수 있으며, Mg, Zn, Ca, Sr, Ba 등의 p형 도펀트가 도핑될 수 있다. 제2 반도체층(104)은 예를 들어, n형 반도체층을 포함하여 형성될 수 있다. n형 반도체층은 In_xAl_yGa_{1-x-y}N (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ x+y ≤ 1)의 조성식을 갖는 반도체 재료, 예를 들어 GaN, AlN, AlGa_{1-x-y}N, InGa_{1-x-y}N, InNInAlGa_{1-x-y}N, AlInN 등에서 선택될 수 있으며, Si, Ge, Sn 등의 n형 도펀트가 도핑될 수 있다.
- [0041] 다만, 본 발명은 이에 한하지 않으며, 제1 반도체층(102)이 n형 반도체층을 포함하고, 제2 반도체층(104)이 p형 반도체층을 포함할 수도 있다.
- [0042] 활성층(103)은 전자와 정공이 재결합되는 영역으로, 전자와 정공이 재결합함에 따라 낮은 에너지 준위로 천이하며, 그에 상응하는 파장을 가지는 빛을 생성할 수 있다. 활성층(103)은 예를 들어, In_xAl_yGa_{1-x-y}N (0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ x+y ≤ 1)의 조성식을 가지는 반도체 재료를 포함하여 형성할 수 있으며, 단일 양자 우물 구조 또는 다중 양자 우물 구조(MQW: Multi Quantum Well)로 형성될 수 있다. 또한, 양자선(Quantum wire)구조 또는 양자점(Quantum dot)구조를 포함할 수도 있다.
- [0043] 제1 반도체층(102)에는 제1 컨택전극(106)이 형성되고, 제2 반도체층(104)에는 제2 컨택전극(107)이 형성될 수

있다. 제1 컨택 전극(106) 및/또는 제2 컨택 전극(107)은 하나 이상의 층을 포함할 수 있으며, 금속, 전도성 산화물 및 전도성 중합체들을 포함한 다양한 전도성 재료로 형성될 수 있다.

- [0044] 성장 기판(101) 위에 형성된 복수의 마이크로 LED(100)를 성장 기판(101)으로부터 분리 가능한 상태가 되도록 할 수 있다.
- [0045] 도 1에서 'p'는 마이크로 LED(100)간의 피치간격을 의미하고, 's'는 마이크로 LED(100)간의 이격 거리를 의미하며, 'w'는 마이크로 LED(100)의 폭을 의미한다.
- [0046] 도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 LED 전사헤드에 의해 표시 기판으로 이송되어 실장됨에 따라 형성된 마이크로 LED 구조체를 도시한 도면이다.
- [0047] 표시 기판(301)은 다양한 소재를 포함할 수 있다. 예를 들어, 표시 기판(301)은 SiO₂를 주성분으로 하는 투명한 유리 재질로 이루어질 수 있다. 그러나, 표시 기판(301)은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 투명한 플라스틱 재질로 형성되어 가용성을 가질 수 있다. 플라스틱 재질은 절연성 유기물인 폴리에테르술폰(PES, polyethersulphone), 폴리아크릴레이트(PAR, polyacrylate), 폴리에테르 이미드(PEI, polyetherimide), 폴리에틸렌 나프탈레이트(PEN, polyethylenenapthalate), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET, polyethyleneterephthalate), 폴리페닐렌 설파이드(polyphenylene sulfide: PPS), 폴리아릴레이트(polyallylate), 폴리이미드(polyimide), 폴리카보네이트(PC), 셀룰로오스 트리 아세테이트(TAC), 셀룰로오스 아세테이트 프로피오네이트(cellulose acetate propionate: CAP)로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 유기물일 수 있다.
- [0048] 화상이 표시 기판(301)방향으로 구현되는 배면 발광형인 경우에 표시 기판(301)은 투명한 재질로 형성해야 한다. 그러나 화상이 표시 기판(301)의 반대 방향으로 구현되는 전면 발광형인 경우에 표시 기판(301)은 반드시 투명한 재질로 형성할 필요는 없다. 이 경우 금속으로 표시 기판(301)을 형성할 수 있다.
- [0049] 금속으로 표시 기판(301)을 형성할 경우 표시 기판(301)은 철, 크롬, 망간, 니켈, 티타늄, 몰리브덴, 스테인레스 스틸(SUS), Invar 합금, Inconel 합금 및 Kovar 합금으로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0050] 표시 기판(301)은 버퍼층(311)을 포함할 수 있다. 버퍼층(311)은 평탄면을 제공할 수 있고, 이물 또는 습기가 침투하는 것을 차단할 수 있다. 예를 들어, 버퍼층(311)은 실리콘 옥사이드, 실리콘 나이트라이드, 실리콘 옥시 나이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루미늄나이트라이드, 티타늄옥사이드 또는 티타늄나이트라이드 등의 무기물이나, 폴리이미드, 폴리에스테르, 아크릴 등의 유기물을 함유할 수 있고, 예시한 재료들 중 복수의 적층체로 형성될 수 있다.
- [0051] 박막 트랜지스터(TFT)는 활성층(310), 게이트 전극(320), 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)을 포함할 수 있다.
- [0052] 이하에서는 박막 트랜지스터(TFT)가 활성층(310), 게이트 전극(320), 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)이 순차적으로 형성된 탑 게이트 타입(top gate type)인 경우를 설명한다. 그러나 본 실시예는 이에 한정되지 않고 바텀 게이트 타입(bottom gate type) 등 다양한 타입의 박막 트랜지스터(TFT)가 채용될 수 있다.
- [0053] 활성층(310)은 반도체 물질, 예컨대 비정질 실리콘(amorphous silicon) 또는 다결정 실리콘(poly crystalline silicon)을 포함할 수 있다. 그러나 본 실시예는 이에 한정되지 않고 활성층(310)은 다양한 물질을 함유할 수 있다. 선택적 실시예로서 활성층(310)은 유기 반도체 물질 등을 함유할 수 있다.
- [0054] 또 다른 선택적 실시예로서, 활성층(310)은 산화물 반도체 물질을 함유할 수 있다. 예컨대, 활성층(310)은 아연(Zn), 인듐(In), 갈륨(Ga), 주석(Sn) 카드뮴(Cd), 게르마늄(Ge) 등과 같은 12, 13, 14족 금속 원소 및 이들의 조합에서 선택된 물질의 산화물을 포함할 수 있다.
- [0055] 게이트 절연막(313: gate insulating layer)은 활성층(310) 상에 형성된다. 게이트 절연막(313)은 활성층(310)과 게이트 전극(320)을 절연하는 역할을 한다. 게이트 절연막(313)은 실리콘산화물 및/또는 실리콘질화물 등의 무기 물질로 이루어진 막이 다층 또는 단층으로 형성될 수 있다.
- [0056] 게이트 전극(320)은 게이트 절연막(313)의 상부에 형성된다. 게이트 전극(320)은 박막 트랜지스터(TFT)에 온/오프 신호를 인가하는 게이트 라인(미도시)과 연결될 수 있다.
- [0057] 게이트 전극(320)은 저저항 금속 물질로 이루어질 수 있다. 게이트 전극(320)은 인접층과의 밀착성, 적층되는

층의 표면 평탄성 그리고 가공성 등을 고려하여, 예컨대 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 은(Ag), 마그네슘(Mg), 금(Au), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 이리듐(Ir), 크롬(Cr), 리튬(Li), 칼슘(Ca), 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 구리(Cu) 중 하나 이상의 물질로 단층 또는 다층으로 형성될 수 있다.

[0058] 게이트 전극(320)상에는 층간 절연막(315)이 형성된다. 층간 절연막(315)은 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)과 게이트 전극(320)을 절연한다. 층간 절연막(315)은 무기 물질로 이루어진 막이 다층 또는 단층으로 형성될 수 있다. 예컨대 무기 물질은 금속 산화물 또는 금속 질화물일 수 있으며, 구체적으로 무기 물질은 실리콘 산화물(SiO_2), 실리콘질화물(SiN_x), 실리콘산질화물(SiON), 알루미늄산화물(Al_2O_3), 티타늄산화물(TiO_2), 탄탈산화물(Ta_2O_5), hafnium산화물(HfO_2), 또는 아연산화물(ZrO_2) 등을 포함할 수 있다.

[0059] 층간 절연막(315) 상에 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)이 형성된다. 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)은 알루미늄(Al), 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 은(Ag), 마그네슘(Mg), 금(Au), 니켈(Ni), 네오디뮴(Nd), 이리듐(Ir), 크롬(Cr), 리튬(Li), 칼슘(Ca), 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 텅스텐(W), 구리(Cu) 중 하나 이상의 물질로 단층 또는 다층으로 형성될 수 있다. 소스 전극(330a) 및 드레인 전극(330b)은 활성층(310)의 소스 영역과 드레인 영역에 각각 전기적으로 연결된다.

[0060] 평탄화층(317)은 박막 트랜지스터(TFT) 상에 형성된다. 평탄화층(317)은 박막 트랜지스터(TFT)를 덮도록 형성되어, 박막 트랜지스터(TFT)로부터 비롯된 단차를 해소하고 상면을 평탄하게 한다. 평탄화층(317)은 유기 물질로 이루어진 막이 단층 또는 다층으로 형성될 수 있다. 유기 물질은 Polymethylmethacrylate(PMMA)나, Polystyrene(PS)과 같은 일반 범용고분자, 페놀계 그룹을 갖는 고분자 유도체, 아크릴계 고분자, 이미드계 고분자, 아릴에테르계 고분자, 아마이드계 고분자, 불소계고분자, p-자일렌계 고분자, 비닐알콜계 고분자 및 이들의 블렌드 등을 포함할 수 있다. 또한, 평탄화층(317)은 무기 절연막과 유기절연막의 복합 적층체로 형성될 수도 있다.

[0061] 평탄화층(317)상에는 제1 전극(510)이 위치한다. 제1 전극(510)은 박막 트랜지스터(TFT)와 전기적으로 연결될 수 있다. 구체적으로, 제1 전극(510)은 평탄화층(317)에 형성된 콘택홀을 통하여 드레인 전극(330b)과 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 전극(510)은 다양한 형태를 가질 수 있는데, 예를 들면 아일랜드 형태로 패터닝되어 형성될 수 있다. 평탄화층(317)상에는 픽셀 영역을 정의하는 뱅크층(400)이 배치될 수 있다. 뱅크층(400)은 마이크로 LED(100)가 수용될 오목부를 포함할 수 있다. 뱅크층(400)은 일 예로, 오목부를 형성하는 제1 뱅크층(410)을 포함할 수 있다. 제1 뱅크층(410)의 높이는 마이크로 LED(100)의 높이 및 시야각에 의해 결정될 수 있다. 오목부의 크기(폭)는 표시 장치의 해상도, 픽셀 밀도 등에 의해 결정될 수 있다. 일 실시예에서, 제1 뱅크층(410)의 높이보다 마이크로 LED(100)의 높이가 더 클 수 있다. 오목부는 사각 단면 형상일 수 있으나, 본 발명의 실시예들은 이에 한정되지 않고, 오목부는 다각형, 직사각형, 원형, 원뿔형, 타원형, 삼각형 등 다양한 단면 형상을 가질 수 있다.

[0062] 뱅크층(400)은 제1 뱅크층(410) 상부의 제2 뱅크층(420)을 더 포함할 수 있다. 제1 뱅크층(410)과 제2 뱅크층(420)은 단차를 가지며, 제2 뱅크층(420)의 폭이 제1 뱅크층(410)의 폭보다 작을 수 있다. 제2 뱅크층(420)의 상부에는 전도층(550)이 배치될 수 있다. 전도층(550)은 데이터선 또는 스캔선과 평행한 방향으로 배치될 수 있고, 제2 전극(530)과 전기적으로 연결된다. 다만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 제2 뱅크층(420)은 생략되고, 제1 뱅크층(410) 상에 전도층(550)이 배치될 수 있다. 또는, 제2 뱅크층(420) 및 전도층(550)을 생략하고, 제2 전극(530)을 픽셀(P)들에 공통인 공통전극으로서 기관(301) 전체에 형성할 수도 있다. 제1 뱅크층(410) 및 제2 뱅크층(420)은 광의 적어도 일부를 흡수하는 물질, 또는 광 반사 물질, 또는 광 산란물질을 포함할 수 있다. 제1 뱅크층(410) 및 제2 뱅크층(420)은 가시광(예를 들어, 380nm 내지 750nm 파장 범위의 광)에 대해 반투명 또는 불투명한 절연 물질을 포함할 수 있다.

[0063] 일 예로, 제1 뱅크층(410) 및 제2 뱅크층(420)은 폴리카보네이트(PC), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에테르설폰, 폴리비닐부티랄, 폴리페닐렌에테르, 폴리아미드, 폴리에테르이미드, 노보넨계(norbornene system) 수지, 메타크릴 수지, 환상 폴리올레핀계 등의 열가소성 수지, 에폭시 수지, 페놀 수지, 우레탄 수지, 아크릴수지, 비닐 에스테르 수지, 이미드계 수지, 우레탄계 수지, 우레아(urea)수지, 멜라민(melamine) 수지 등의 열경화성 수지, 혹은 폴리스티렌, 폴리아크릴로니트릴, 폴리카보네이트 등의 유기 절연 물질로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0064] 다른 예로, 제1 뱅크층(410) 및 제2 뱅크층(420)은 SiO_x , SiN_x , SiN_xO_y , AlO_x , TiO_x , TaO_x , ZnO_x 등의 무기산화물, 무기질화물 등의 무기 절연 물질로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 일 실시예에서, 제1 뱅

크층(410) 및 제2 बैं크층(420)는 블랙 매트릭스(black matrix) 재료와 같은 불투명 재료로 형성될 수 있다. 절연성 블랙 매트릭스 재료로는 유기 수지, 글래스 페이스트(glass paste) 및 흑색 안료를 포함하는 수지 또는 페이스트, 금속 입자, 예컨대 니켈, 알루미늄, 폴리브덴 및 그의 합금, 금속 산화물 입자(예를 들어, 크롬 산화물), 또는 금속 질화물 입자(예를 들어, 크롬 질화물) 등을 포함할 수 있다. 변형례에서 제1 बैं크층(410) 및 제2 बैं크층(420)는 고반사율을 갖는 분산된 브래그 반사체(DBR) 또는 금속으로 형성된 미러 반사체일 수 있다.

[0065] 오목부에는 마이크로 LED(100)가 배치된다. 마이크로 LED(100)는 오목부에서 제1 전극(510)과 전기적으로 연결될 수 있다.

[0066] 마이크로 LED(100)는 적색, 녹색, 청색, 백색 등의 파장을 가지는 빛을 방출하며, 형광 물질을 이용하거나 색을 조합함으로써 백색광도 구현이 가능하다. 마이크로 LED(100)는 1 μm 내지 100 μm 의 크기를 갖는다. 마이크로 LED(100)는 개별적으로 또는 복수 개가 본 발명의 실시예에 따른 전사헤드에 의해 성장 기관(101) 상에서 픽업(pick up)되어 표시 기관(301)에 전사됨으로써 표시 기관(301)의 오목부에 수용될 수 있다.

[0067] 마이크로 LED(100)는 p-n 다이오드, p-n 다이오드의 일측에 배치된 제1 컨택 전극(106) 및 제1 컨택 전극(106)과 반대측에 위치한 제2 컨택 전극(107)을 포함한다. 제1 컨택 전극(106)은 제1 전극(510)과 접촉하고, 제2 컨택 전극(107)은 제2 전극(530)과 접촉할 수 있다.

[0068] 제1 전극(510)은 Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr 및 이들의 화합물 등으로 형성된 반사막과, 반사막 상에 형성된 투명 또는 반투명 전극층을 구비할 수 있다. 투명 또는 반투명 전극층은 인듐틴옥사이드(ITO; indium tin oxide), 인듐징크옥사이드(IZO; indium zinc oxide), 징크옥사이드(ZnO; zinc oxide), 인듐옥사이드(In_2O_3 ; indium oxide), 인듐갈륨옥사이드(IGO; indium gallium oxide) 및 알루미늄징크옥사이드(AZO; aluminum zinc oxide)를 포함하는 그룹에서 선택된 적어도 하나 이상을 구비할 수 있다.

[0069] 패시베이션층(520)은 오목부 내의 마이크로 LED(100)를 둘러싼다. 패시베이션층(520)은 बैं크층(400)과 마이크로 LED(100) 사이의 공간을 채움으로써, 오목부 및 제1 전극(510)을 커버한다. 패시베이션층(520)은 유기 절연물질로 형성될 수 있다. 예를 들어, 패시베이션층(520)은 아크릴, 폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA), 벤조사이클로부텐(BCB), 폴리이미드, 아크릴레이트, 에폭시 및 폴리에스테르 등으로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0070] 패시베이션층(520)은 마이크로 LED(100)의 상부, 예컨대 제2 컨택 전극(107)은 커버하지 않는 높이로 형성되어, 제2 컨택 전극(107)은 노출된다. 패시베이션층(520) 상부에는 마이크로 LED(100)의 노출된 제2 컨택 전극(107)과 전기적으로 연결되는 제2 전극(530)이 형성될 수 있다.

[0071] 제2 전극(530)은 마이크로 LED(100)와 패시베이션층(520)상에 배치될 수 있다. 제2 전극(530)은 ITO, IZO, ZnO 또는 In_2O_3 등의 투명 전도성 물질로 형성될 수 있다.

[0073] 제1실시예

[0074] 도 3(a)는 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)을 구성하는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 클리닝 장치 방향으로 하강하기 전 상태를 도시한 도이고, 도 3(b)는 본 발명의 바람직한 제1실시예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)을 구성하는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 클리닝 장치 방향으로 하강하여 클리닝 공간(1300)이 밀폐된 상태를 도시한 도이다.

[0075] 본 발명의 제1실시예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 흡착면으로 마이크로 LED(100)를 흡착하고 흡착면보다 하부로 돌출되도록 테두리에 형성되는 실링부(1100)를 포함하는 마이크로 LED 전사헤드(1000)와, 흡착면을 세척하는 클리닝 장치(1200)를 포함하여 구성된다.

[0076] 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 흡입력을 이용하여 마이크로 LED(100)를 흡착하거나 탈착할 수 있다. 이 경우, 기공을 갖는 다공성 부재로 흡착면을 구성하여 다공성 부재의 기공에 진공을 가하여 진공 흡입력으로 마이크로 LED(100)를 흡착할 수 있다. 다공성 부재의 상부에는 진공을 공급하거나 진공을 해제는 진공 포트에 연결되어 진공 포트의 작동에 따라 다공성 부재의 다수의 기공에 진공을 가하거나 기공에 가해진 진공을 해제하는 진공 챔버가 구비될 수 있다. 진공챔버를 다공성 부재에 결합하는 구조는 다공성 부재에 진공을 가하거나 가해진 진공을 해제함에 있어서 다른 부위의 진공의 누설을 방지하는데 적절한 구조라면 이에 대한 한정은 없다.

- [0077] 다공성 부재는 내부에 기공이 다수 함유되어 있는 물질을 포함하여 구성되며, 일정 배열 또는 무질서한 기공구조로 0.2~0.95 정도의 기공도를 가지는 분말, 박막/후막 및 벌크 형태로 구성될 수 있다. 다공성 부재(1100)의 기공은 그 크기에 따라 직경 2 nm 이하의 마이크로(micro)기공, 2~50 nm 메조(meso)기공, 50 nm 이상의 매크로(macro)기공으로 구분할 수 있는데, 이들의 기공들을 적어도 일부를 포함한다. 다공성 부재(1100)는 그 구성 성분에 따라서 유기, 무기(세라믹), 금속, 하이브리드형 다공성 소재로 구분 가능하다.
- [0078] 다공성 부재는 기공이 일정 배열로 형성되는 양극산화막을 포함한다. 양극산화막은 모재인 금속을 양극산화하여 형성된 막을 의미하고, 기공은 금속을 양극산화하여 양극산화막을 형성하는 과정에서 형성되는 구멍을 의미한다. 예컨대, 모재인 금속이 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 합금인 경우, 모재를 양극산화하면 모재의 표면에 양극산화알루미늄(Al_2O_3) 재질의 양극산화막(1300)이 형성된다. 위와 같이, 형성된 양극산화막은 내부에 기공이 형성되지 않은 배리어층과, 내부에 기공이 형성된 다공층으로 구분된다. 배리어층은 모재의 상부에 위치하고, 다공층은 배리어층의 상부에 위치한다. 이처럼, 배리어층과 다공층을 갖는 양극산화막이 표면에 형성된 모재에서, 모재를 제거하게 되면, 양극산화알루미늄(Al_2O_3) 재질의 양극산화막만이 남게 된다.
- [0079] 양극산화막은, 지름이 균일하고, 수직인 형태로 형성되면서 규칙적인 배열을 갖는 기공을 갖게 된다. 따라서, 배리어층을 제거하면, 기공은 상, 하로 수직하게 관통된 구조를 갖게 되며, 이를 통해 수직한 방향으로 진공압을 형성하는 것이 용이하게 된다.
- [0080] 양극산화막의 내부는 수직 형상의 기공에 의해 수직인 형태의 공기 유로를 형성할 수 있게 된다. 기공의 내부 폭은 수 nm 내지 수 백nm의 크기를 갖는다. 예를 들어, 진공 흡착하고자 하는 마이크로 LED의 사이즈가 $30\mu m \times 30\mu m$ 인 경우이고 기공의 내부 폭이 수 nm인 경우에는 대략 수 천만개의 기공을 이용하여 마이크로 LED(100)를 진공 흡착할 수 있게 된다.
- [0081] 한편, 진공 흡착하고자 하는 마이크로 LED(100)의 사이즈가 $30\mu m \times 30\mu m$ 인 경우이고 기공의 내부 폭이 수 백 nm인 경우에는 대략 수 만개의 기공을 이용하여 마이크로 LED(100)를 진공 흡착할 수 있게 된다. 마이크로 LED(100)의 경우에는 기본적으로 제1 반도체층(102), 제2 반도체층(104), 제1 반도체층(102)과 제2 반도체층(104) 사이에 형성된 활성층(103), 제1 컨택전극(106) 및 제2 컨택전극(107)만으로 구성됨에 따라 상대적으로 가벼운 편이므로 양극산화막의 수만 내지 수 천만개의 기공을 이용하여 진공 흡착하는 것이 가능한 것이다.
- [0082] 다공성 부재는 형상의 측면에서 분말, 코팅막, 벌크가 가능하고, 분말의 경우 구형, 중공구형, 화이버, 튜브형 등 다양한 형상이 가능하며, 분말을 그대로 사용하는 경우도 있지만, 이를 출발물질로 코팅막, 벌크 형상을 제조하여 사용하는 것도 가능하다.
- [0083] 또한, 다공성 부재는 제1, 2다공성부재의 이중 구조를 포함하여 구성될 수 있다. 제1다공성 부재의 상부에는 제2다공성 부재가 구비된다. 제1다공성 부재는 마이크로 LED(100)를 진공 흡착하는 기능을 수행하는 구성이고, 제2다공성 부재는 진공챔버와 제1다공성 부재 사이에 위치하여 진공 챔버의 진공압을 제1다공성 부재에 전달하는 기능을 수행한다.
- [0084] 제1,2다공성 부재는 서로 다른 다공성의 특성을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1,2다공성 부재는 기공의 배열 및 크기, 다공성 부재의 소재, 형상 등에서 서로 다른 특성을 가진다.
- [0085] 기공의 배열 측면에서 살펴보면, 제1,2다공성 부재 중 하나는 기공이 일정한 배열을 갖는 것이고 다른 하나는 기공이 무질서한 배열을 갖는 것일 수 있다. 기공의 크기 측면에서 살펴보면, 제1,2다공성 부재 중 어느 하나는 기공의 크기가 다른 하나에 비해 큰 것일 수 있다. 여기서 기공의 크기는 기공의 평균 크기일 수 있고, 기공 중에서의 최대 크기일 수 있다. 다공성 부재의 소재 측면에서 살펴보면, 어느 하나가 유기, 무기(세라믹), 금속, 하이브리드형 다공성 소재 중 하나의 소재로 구성되면 다른 하나는 어느 하나의 소재와는 다른 소재로서 유기, 무기(세라믹), 금속, 하이브리드형 다공성 소재 중에서 선택될 수 있다. 다공성 부재의 형상 측면에서 살펴보면, 제1,2다공성 부재의 형상은 서로 상이하게 구성될 수 있다.
- [0086] 이처럼 제1,2다공성 부재의 기공의 배열 및 크기, 소재 및 형상 등을 서로 달리함으로써 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 기능을 다양하게 할 수 있고, 제1,2다공성 부재의 각각에 대한 상보적인 기능을 수행할 수 있게 할 수 있다. 다공성 부재의 개수는 제1,2다공성 부재처럼 2개로 한정되는 것은 아니며 각각의 다공성 부재가 서로 상보적인 기능을 갖는 것이라면 그 이상으로 구비되는 것도 실시예의 범위에 포함된다.
- [0087] 다공성 부재의 기공이 무질서한 기공구조를 갖는 경우에는, 다공성 부재의 내부는 다수의 기공들이 서로 연결되면서 다공성 부재의 상, 하를 연결하는 공기 유로를 형성하게 된다. 한편, 다공성 부재의 기공이 수직형상의 기

공구조를 갖는 경우에는, 다공성 부재의 내부는 수직 형상의 기공에 의해 다공성 부재의 상, 하로 관통되면서 공기 유로를 형성할 수 있도록 한다.

[0088] 제1다공성 부재가 금속을 양극산화하여 형성된 기공을 갖는 양극산화막으로 구비될 경우, 제2다공성 부재는 제1다공성 부재를 지지하는 기능을 갖는 다공성 지지체로 구성될 수 있다. 제2다공성 부재가 제1다공성 부재를 지지하는 기능을 달성할 수 있는 구성이라면 그 재료에는 한정이 없으며, 전술한 다공성 부재(1100)의 구성이 포함될 수 있다. 제2다공성 부재는 제1다공성 부재의 중앙 처짐 현상 방지에 효과를 갖는 경질의 다공성 지지체로 구성될 수 있다. 예컨대, 제2다공성 부재는 다공성 세라믹 소재일 수 있다.

[0089] 이외에도 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 정전기력, 자기력, 반데르발스력 등을 이용하여 마이크로 LED(100)를 흡착하거나 탈착할 수 있다.

[0090] 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 흡착면보다 하부로 돌출되도록 테두리에 실링부(1100)가 형성된다. 도 3에 도시된 바와 같이, 제1실시 예의 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 테두리에 흡착면보다 하부로 돌출되도록 실링부(1100)가 형성된다. 여기서, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 테두리는, 성장 기관(101)의 상면에 마이크로 LED(100)가 칩핑되면서 존재하는 마이크로 LED 존재영역에 대응되는 마이크로 LED 전사헤드(1000) 영역의 바깥부분을 의미할 수 있다.

[0091] 도 3(b)와 같이, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 흡착면의 세척을 위해 클리닝 장치(1200) 상면 방향으로 하강할 경우, 실링부(1100)는 클리닝 장치(1200)의 상면에 접촉한다. 실링부(1100)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 테두리에 흡착면보다 하부로 돌출되도록 형성되므로, 실링부(1100)의 하면이 클리닝 장치(1200)의 상면에 접촉한다. 이로 인해 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 하단부가 클리닝 장치(1200)의 상면과 이격되게 위치하면서 형성되는 클리닝 공간(1300)이 밀폐된다. 실링부(1100)는 클리닝 공간(1300)으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 때 흡착면의 세척 효율을 높일 수 있다. 실링부(1100)는 탄성재질로 구성되어 클리닝 공간(1300)으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단할 뿐만 아니라 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착면에 흡착하기 위하여 하강할 경우, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 기계적 공차로 인한 이송 오차를 수용하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)와 마이크로 LED(100)상면이 충돌하여 마이크로 LED(100)가 파손되지 않도록 완충의 기능을 수행할 수 있다.

[0092] 본 발명의 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 실링부(1100)에 의해 클리닝 공간(1300)이 밀폐되어 외부 이물질의 유입이 차단되고, 밀폐된 클리닝 공간(1300)의 이물질과 흡착면의 이물질을 클리닝 장치(1200)를 통해 제거할 수 있다.

[0093] 클리닝 장치(1200)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척하는 기능을 한다.

[0094] 클리닝 장치는 플라즈마를 발생하는 장치일 수 있다. 클리닝 장치(1200)가 플라즈마를 발생하는 장치일 경우, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면에 플라즈마를 발생시켜 흡착면에 흡착된 이물질을 세척할 수 있다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면은 마이크로 LED(100)가 흡착되는 면이다. 그러므로, 반복적인 흡착으로 발생하는 이물질을 세척하지 않으면 흡착력이 낮아질 수 있다. 예컨대, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 다공성 부재로 흡착면이 구성되어 있다면 이물질이 기공을 막아 흡착력이 저하되는 문제가 발생할 수 있다. 클리닝 장치(1200)는 플라즈마를 발생하여 이와 같이 흡착력을 방해하는 흡착면의 이물질을 제거할 수 있다. 클리닝 장치(1200)가 발생한 플라즈마는 이물질을 태워서 제거할 수 있다. 여기서, 이물질은 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면에 형성된 이물질일 수 있고, 클리닝 공간(1300)에 존재하는 이물질일 수 있다. 클리닝 장치(1200)가 플라즈마를 발생하는 장치라면 클리닝 장치(1200)가 발생한 플라즈마에 의해 이물질이 제거되어 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 마이크로 LED(100)를 보다 효과적으로 전사할 수 있게 된다.

[0095] 클리닝 장치(1200)는 퍼지 가스를 분사하는 장치일 수 있다. 클리닝 장치(1200)는 퍼지 가스를 분사하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 이물질과 같은 흡착력 방해 요인을 제거할 수 있다. 클리닝 장치(1200)는 퍼지 가스를 분사하는 장치일 경우, 분사 노즐이 복수개가 설치되어 각각의 분사 노즐에서 가스를 분사하는 구조이거나, 분사되는 가스의 압력과 양을 균일하게 하는 면분사의 형태로 구성될 수 있다. 면분사 형태는 다수의 기공 또는 구멍을 갖는 플레이트를 상판으로 구비하거나 다공성 부재를 이용하여 구비될 수 있다.

[0096] 클리닝 장치(1200)가 분사하는 퍼지 가스는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하는데 방해가 되는 정전기와 같은 방해 요인을 세척하여 제거할 수 있다. 예컨대, 다공성 부재로 흡착면이 구성된 마이크로 LED 전사헤드가 마이크로 LED(100)를 전사하는 과정에서 마이크로 LED 전사헤드, 마이크로 LED(100) 및 표시 기관(301) 간의 사이에서 두 부재간의 접촉, 마찰, 박리 등의 이유 및 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이

크로 LED(100)를 진공 흡입력으로 흡착하는 과정에서 기공 내부에 발생하는 공간의 흐름 등의 이유로 정전기가 발생할 수 있다. 정전기력을 이용하여 마이크로 LED(100)를 흡착하는 경우에 있어서는 정전기가 적극적으로 유도되어야 하지만, 정전기력을 이용하지 않는 경우에는 정전기력은 마이크로 LED(100)를 흡착함에 있어서는 제거되어야 할 부정적인 것이다. 클리닝 장치(1200)는 퍼지 가스를 분사하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면에 기 형성된 정전기를 제거할 수 있다. 여기서 퍼지 가스는 정전기를 제거할 수 있는 가스라면 이에 대한 한정은 없다. 예컨대, 퍼지 가스는 이온화된 가스일 수 있다. 이온화된 가스가 다공성 부재로 흡착면이 구성된 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면으로 분사되면서 마이크로 LED 전사헤드의 흡착면에 발생한 정전기를 제거할 수 있다.

[0097] 한편, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하는데 방해가 되는 방해 요인은 이물질일 수 있다. 예컨대, 다공성 부재로 흡착면이 구성되는 마이크로 LED 전사헤드는 미세한 많은 기공을 포함하고 있기 때문에 전사 과정에서의 이물질이 다공성 부재의 흡착면에 달라 붙어 기공을 막는 문제를 야기할 수 있다. 이물질이 다공성 부재의 기공을 막게 되면, 마이크로 LED 전사헤드의 흡착력이 저하된다. 또한, 이물질이 다공성 부재의 일부영역의 기공을 막게 되면 해당 일부 영역에서의 마이크로 LED(100)에 대한 흡착력이 불균일해진다는 문제를 야기할 수 있다. 따라서, 이물질은 다공성 부재의 흡착면에서 세척을 통해 제거되어야 하는 방해 요인이 된다.

[0098] 이와 같은 이물질을 세척을 통해 제거하기 위해 클리닝 장치(1200)는 퍼지 가스를 흡착면에 분사할 수 있다. 여기서, 퍼지 가스는 이물질을 제거하는데 바람직한 가스라면 그에 대한 한정은 없다. 예컨대, 퍼지 가스는 질소, 아르곤 등을 포함하는 불활성 가스일 수 있다.

[0099] 클리닝 장치(1200)는 이온풍을 분사하는 장치일 수 있다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 전사과정에서 마찰 등의 원인에 의해 성장 기관(101)과 마이크로 LED 전사헤드(1000) 사이 또는 표시 기관(301)과 마이크로 LED 전사헤드(1000) 사이에서 대전에 의한 정전기가 발생할 수 있다. 이로 인해 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 성장 기관(101)으로부터 마이크로 LED(100)를 흡착한 후, 표시 기관(301)으로 마이크로 LED(100)를 실장시키는 언로딩 공정에서 마이크로 LED(100)가 마이크로 LED 전사헤드(1000)에 달라 붙어 위치가 틀어진 채 표시 기관(301)으로 언로딩 되거나, 언로딩 자체를 수행할 수 없는 문제가 발생할 수 있다. 클리닝 장치(1200)는 이온풍을 분사함으로써 흡착면에 발생된 정전기를 세척하여 제거할 수 있다.

[0100] 클리닝 장치(1200)는 정전기를 제거하는 장치일 수 있다. 예컨대, 정전기를 제거하는 장치인 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)일 수 있다. 정전기를 제거하는 클리닝 장치(1200)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면에 접촉함으로써 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 전사과정에서 마찰 등의 원인에 의해 발생하는 정전기를 제거할 수 있다.

[0101] 또한, 클리닝 장치(1200)는 이물질을 닦아서 세척하는 장치이거나, 세정액을 분사하여 세척하는 장치일 수 있으며, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 흡착을 방해하는 요인을 세척을 통해 제거할 수 있는 장치라면 이에 대한 한정은 없다. 여기서 세정액을 분사하는 경우에는, 클리닝 장치(1200) 내부 또는 외부에 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 건조하는 건조 장치가 추가로 구비될 수 있다.

[0102] 클리닝 장치(1200)를 포함하여 구성된 제1실시 예의 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 다음과 같이 배치되어 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 수 있다.

[0103] 도 4는 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)의 배치를 도시한 도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템은 흡착면보다 하부로 돌출되도록 테두리에 실링부가 형성된 마이크로 LED 전사헤드(1000)와 클리닝 장치(1200)로 구성되어, 클리닝 장치(1200)가, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하기 전의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면 또는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 이송하여 실장시킨 후의 마이크로 LED 전사헤드의 흡착을 세척한다.

[0104] 도 4를 참조하면, 본 발명의 제1실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 클리닝 장치(1200), 성장 기관(101) 및 표시 기관(301)이 공정 순서에 따라 순차적으로 배치된다. 본 발명에서는 클리닝 장치(1200)가 공정 순서로 클리닝 장치(1200), 성장 기관(101) 및 표시 기관(301) 또는 성장 기관(101), 표시 기관(301) 및 클리닝 장치(1200)로 배치되는 것을 하나의 도면에 도시하여 클리닝 장치(1200)가 성장 기관(101) 전과 표시 기관(301) 후에 도시되었지만, 클리닝 장치(1200)는 공정 순서에 적합하게 클리닝 장치(1200), 성장 기관(101) 및 표시 기관(301) 또는 성장 기관(101), 표시 기관(301) 및 클리닝 장치(1200)로 배치된다.

- [0105] 먼저, 클리닝 장치(1200)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하기 전의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 수 있다.
- [0106] 이 경우, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 가이드 부재(1400) 상에서 수평방향으로 이동가능하게 설치된다.
- [0107] 우선 마이크로 LED 전사헤드는 클리닝 장치(1200)의 상부로 이동한다. 이후, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 클리닝 장치(1200) 측으로 하강한다. 이로 인해 실링부(1100)가 클리닝 장치(1200)의 상면에 접촉하면서 클리닝 공간(1300)이 밀폐된다. 클리닝 장치(1200)는 밀폐된 클리닝 공간(1300)의 이물질 및 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 이물질을 세척할 수 있다. 여기서 클리닝 장치(1200)는 플라즈마 발생 장치, 퍼지 가스 분사 장치, 이온풍 분사 장치, 정전기 제거 장치, 이물질을 닦아서 세척하거나 세정액을 분사하는 장치 등 흡착력을 저하시키는 이물질과 같은 방해 요인을 세척할 수 있는 장치 일 수 있다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 클리닝 장치(1200)의 상부에서 다시 상승한다.
- [0108] 다음으로 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 가이드 부재(1400)를 따라 수평방향으로 이동하여 성장 기관(101)의 상부에 위치한다. 성장 기관(101)은 베이스 부재(1500) 상에 구비된다. 성장 기관(101)에는 마이크로 LED(100)가 제작되어 칩핑된 상태로 분리가능하게 구비된다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 하강하여 성장 기관(101) 상에서 마이크로 LED(100)를 흡착한 다음, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 다시 상승한다.
- [0109] 이후, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 가이드 부재(1400)를 따라 수평방향으로 이동하여 표시 기관(301)의 상부에 위치한다. 표시 기관(301)은 베이스 부재(1500) 상에 구비된다. 표시 기관(301)은 임시 지지기관일 수 있거나, TFT를 포함한 회로부가 구성될 수 있다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 하강하여 표시 기관(301)에 마이크로 LED(100)를 전사한 다음, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 다시 상승한다.
- [0110] 한편, 클리닝 장치(1200)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 이송하여 실장 시킨 후의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 표면을 세척할 수 있다.
- [0111] 우선 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 성장 기관(101)의 상부로 이동한다. 그 다음 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 성장 기관(101) 측으로 하강한다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 성장 기관(101)에 칩핑된 마이크로 LED(100)를 흡착한 다음 다시 상승한다.
- [0112] 이후, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 가이드 부재(1400)를 따라 수평방향으로 이동하여 표시 기관(301)의 상부에 위치한다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 하강하여 표시 기관(301)에 마이크로 LED(100)를 전사한 다음 다시 상승한다.
- [0113] 그 다음 가이드 부재(1400)를 따라 수평방향으로 이동하여 클리닝 장치(1200)의 상부에 위치한다. 이후, 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 클리닝 장치(1200) 측으로 하강한다. 이로 인해 실링부(1100)가 클리닝 장치(1200)의 상면에 접촉하면서 클리닝 공간이 밀폐된다. 클리닝 장치(1200)는 밀폐된 클리닝 공간(1300)의 이물질 및 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 이물질을 세척한다.
- [0114] 제1실시 예의 마이크로 LED 전사시스템(1)의 마이크로 LED 전사헤드(1000)는 이와 같은 과정을 반복하기 위하여 가이드 부재(1400)를 따라 이동하여 초기 위치로 수평 이동한다. 여기서, 초기 위치는 공정 순서에 따라 다를 수 있다. 클리닝 장치(1200)가, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하기 전의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 경우, 초기 위치는 클리닝 장치(1200)의 상부를 의미한다. 한편, 클리닝 장치(1200)가, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 이송하여 실장시킨 후의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 경우, 초기 위치는 성장 기관(101) 상부를 의미한다.
- [0115] 또한, 본 발명에는 도시되지 않았지만, 제1실시 예의 마이크로 LED 전사시스템(1)은 클리닝 장치(1200)로 흡착면의 세척을 수행한 후, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면이 제대로 세척되었는지 흡착면을 검사하는 과정을 수행할 수 있다. 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 검사하는 과정은 마이크로 LED 전사시스템(1)의 공정 순서에 따라 적합하게 추가되어 수행될 수 있다.
- [0116] 이와 같이, 제1실시 예의 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 마이크로 LED 전사헤드(1000)에 구비된 실링부(1100)를 통해 클리닝 공간(1300)을 밀폐하여 외부 이물질 유입을 차단할 수 있으므로 클리닝 장치(1200)의 마이크로 LED 전사헤드(1000) 흡착면에 대한 세척 효율을 높일 수 있게 된다.
- [0117]
- [0118] 이하의 제2실시 예의 마이크로 LED 전사시스템(1)은 제1실시 예의 마이크로 LED 전사시스템(1)의 마이크로 LED

전사헤드(1000)에 형성된 실링부(1100)가 클리닝 장치(1200)에 구비되는 구성으로 변경한 실시 예이다. 따라서, 클리닝 장치(1200)의 구성은 앞서 설명한 제1실시 예의 클리닝 장치(1200)의 구성과 동일하므로 이하에서는 이에 대한 자세한 설명은 생략한다.

[0120] 제2실시예

[0121] 이하, 본 발명의 제2실시 예에 대해 설명한다. 단, 이하 설명되는 실시 예는 제1실시 예와 비교하여 특징적인 구성요소들을 중심으로 설명하겠으며, 제1실시 예와 동일하거나 유사한 구성요소들에 대한 설명은 생략한다.

[0122] 도 5는 본 발명의 바람직한 제2실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)을 도시한 도이다.

[0123] 제2실시 예에 따른 마이크로 LED 전사 시스템(1)은 흡착면으로 마이크로 LED(100)를 흡착하는 마이크로 LED 전사헤드(1000), 흡착면을 세척하는 클리닝 장치(1200)를 포함하여 구성된다.

[0124] 흡착면을 세척하는 클리닝 장치(1200)에는 클리닝 장치(1200)의 테두리에 클리닝 장치(1200)의 상부로 돌출되도록 실링부(1100)가 형성된다. 여기서, 클리닝 장치(1200)의 테두리는 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 성장 기판(101)의 마이크로 LED(100)를 흡착하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면 상에 마이크로 LED(100)가 흡착되어 존재하는 마이크로 LED 존재영역과 대응되는 클리닝 장치(1200)의 영역의 바깥 부분을 의미한다.

[0125] 도 5에 도시된 바와 같이, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 흡착면의 세척을 위해 클리닝 장치(1200)의 상면 방향으로 하강할 경우, 실링부(1100)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 테두리의 하면에 접촉한다. 이로 인해 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 하단부가 클리닝 장치(1200)의 상면과 이격되게 위치하면서 형성되는 클리닝 공간(1300)이 밀폐된다. 실링부(1100)는 클리닝 장치(1200)가 마이크로 LED 전사헤드(1000)를 세척할 때 클리닝 공간(1300)으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단한다. 이로 인해 클리닝 공간(1300)에는 클리닝 공간(1300)의 이물질과 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 이물질만이 존재할 수 있다. 따라서, 클리닝 장치(1200)가 작동하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 때 외부 이물질이 클리닝 공간(1300)으로 유입되어 세척을 방해 하지 않으므로 클리닝 장치(1200)의 이물질을 세척하는 기능이 더욱 충실이 수행될 수 있다.

[0126] 실링부(1100)는 탄성재질로 구성된다. 이로 인해 클리닝 공간(1300)을 밀폐하여 외부 이물질을 차단하는 기능뿐만 아니라 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하기 위해 하강할 경우, 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 기계적 공차로 인한 이송 오차를 수용하여 마이크로 LED(100)의 파손을 방지하는 완충의 기능을 수행할 수 있다.

[0127] 클리닝 장치(1200)는 플라즈마 발생 장치, 퍼지 가스 분사 장치, 이온풍 분사 장치, 정전기 제거 장치, 이물질을 닦아서 세척하는 장치, 세정액을 분사 하는 장치 등일 수 있다. 다만, 클리닝 장치(1200)는 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착력을 저하시키는 방해 요인을 세척하여 제거할 수 있는 장치라면 이에 대한 한정은 없다.

[0128] 제2실시 예의 클리닝 장치(1200)는 도 4와 같이, 제1실시 예의 클리닝 장치(1200)가 배치된 것과 같이 공정 순서에 따라 배치되어 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 흡착하기 전의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척하거나, 마이크로 LED 전사헤드(1000)가 마이크로 LED(100)를 이송하여 실장시킨 후의 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 수 있다. 또한, 제2실시 예는 흡착면의 세척을 검사하는 과정이 마이크로 LED 전사시스템(1)의 공정 순서에 적합하게 추가되어 수행될 수 있다.

[0129] 이와 같이 본 발명의 실시 예들은 실링부(1100)를 구비하여 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면의 흡착을 저하시키는 이물질과 같은 방해 요인을 세척할 시, 클리닝 공간(1300)을 밀폐하여 클리닝 공간(1300)으로 외부 이물질이 유입되는 것을 차단할 수 있다. 이로 인해 클리닝 공간(1300)에는 클리닝 공간(1300)의 이물질과 흡착면의 이물질만이 존재하게 된다. 클리닝 장치(1200)는 클리닝 공간(1300)에 유입된 외부 이물질로 인한 방해 없이 마이크로 LED 전사헤드(1000)의 흡착면을 세척할 수 있으므로 마이크로 LED 전사 시스템의 세척 효율을 향상시킬 수 있게 된다.

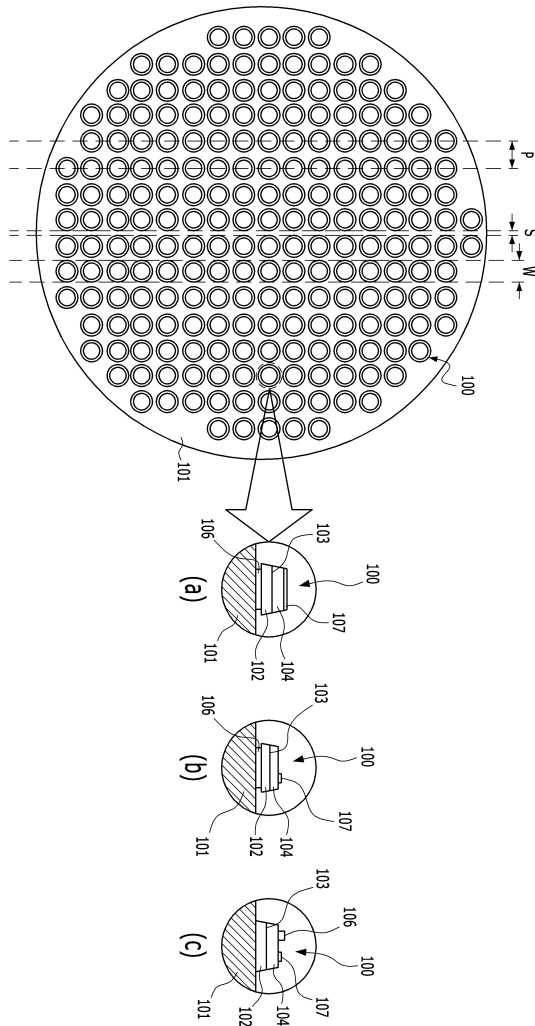
[0130] 전술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시 예들을 참조하여 설명 하였지만, 해당 기술분야의 통상의 기술자는 하기의 특허 청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 또는 변형하여 실시할 수 있다.

부호의 설명

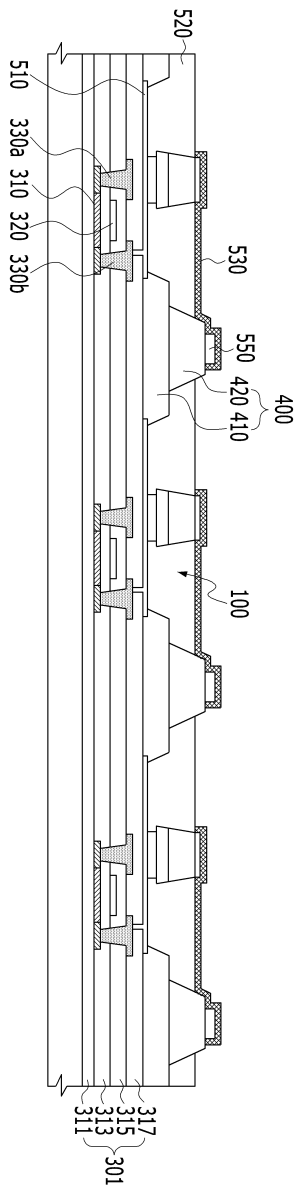
- [0131] 1: 마이크로 LED 전사 시스템 1000: 마이크로 LED 전사헤드
- 1100: 실링부 1200: 클리닝 장치
- 1300: 클리닝 공간 1400: 가이드 부재
- 1500: 베이스 부재 100: 마이크로 LED
- 101: 성장 기판 301: 표시 기판

도면

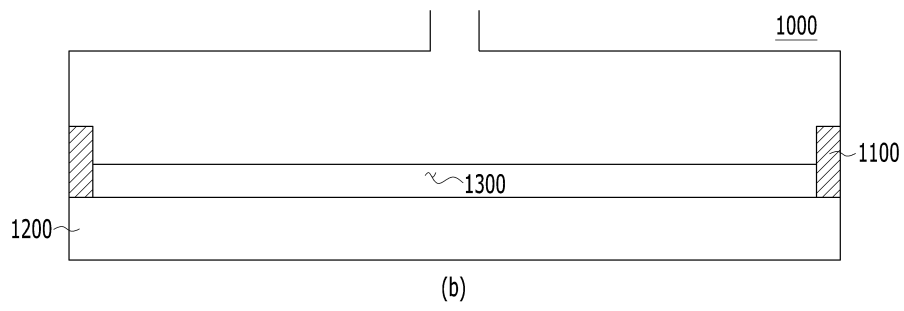
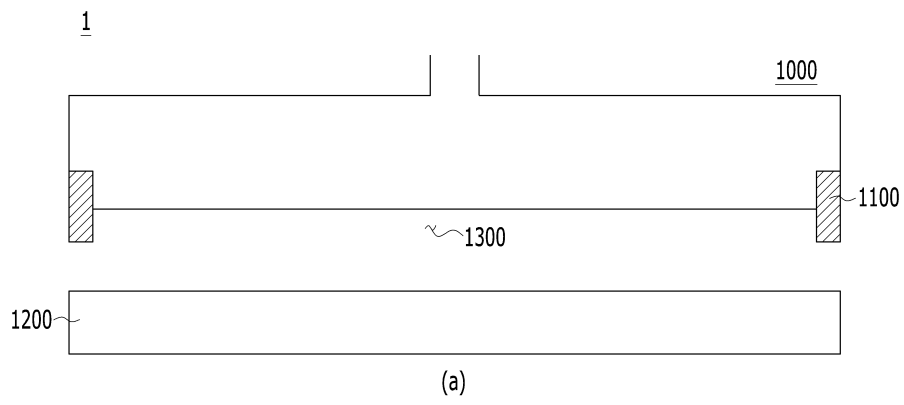
도면1



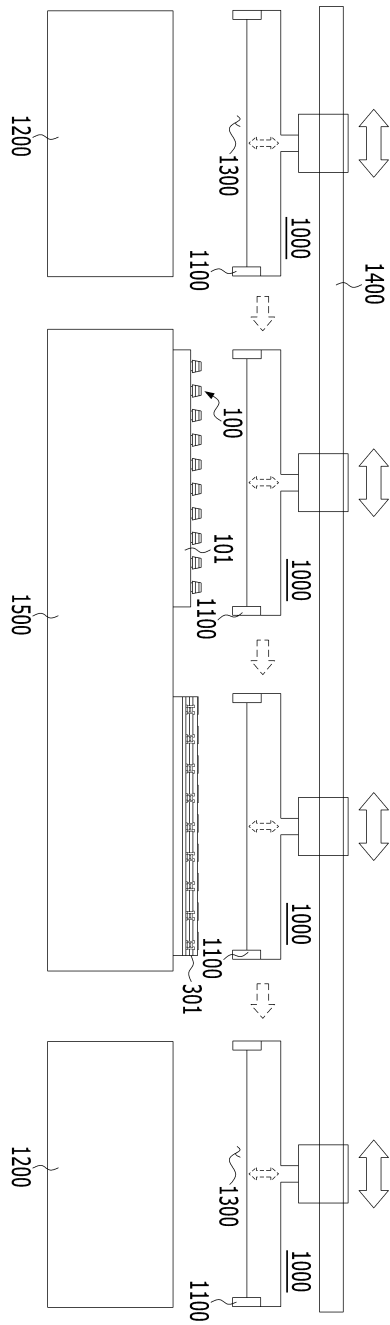
도면2



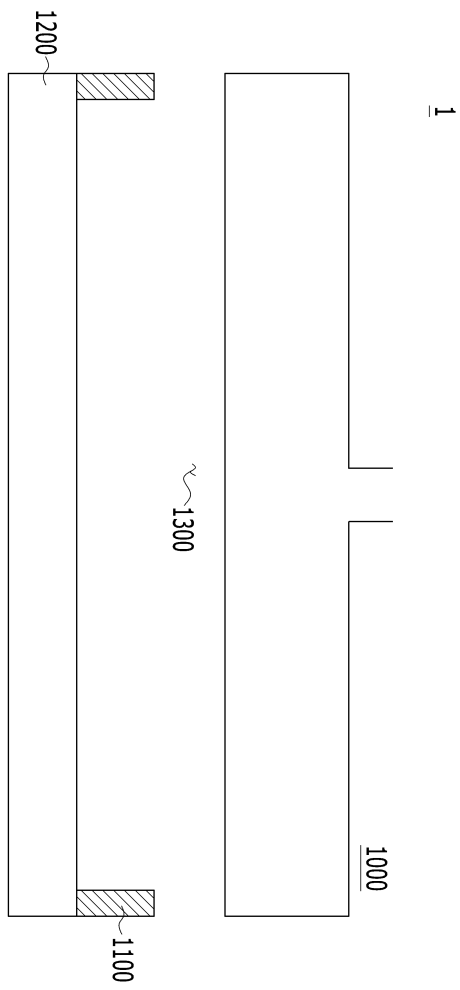
도면3



도면4



도면5



专利名称(译)	微型LED传输系统		
公开(公告)号	KR1020190135862A	公开(公告)日	2019-12-09
申请号	KR1020180061372	申请日	2018-05-29
[标]申请(专利权)人(译)	普因特工程有限公司		
申请(专利权)人(译)	(注)点工程		
[标]发明人	안범모 박승호 변성현		
发明人	안범모 박승호 변성현		
IPC分类号	H01L21/67 H01L21/677 H01L25/075		
CPC分类号	H01L21/67144 H01L21/67712 H01L21/67721 H01L25/0753		
代理人(译)	Choegwangseok		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

微型LED传送系统技术领域本发明涉及一种微型LED传送系统，其可以通过防止外部异物进入构造成在清洗时进行微型LED传送头的清洁的空间中而提高微型LED传送头的吸附表面的清洁效率。清洁微型LED传输头的吸附表面。

